

2015年6月17日

## 組込み型不揮発性メモリーを開発する 株式会社フローディアへの出資を決定

株式会社産業革新機構（以下「INCJ」）（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：能見公一）は、組込み型不揮発性メモリー\*を開発する株式会社フローディア（以下「フローディア」）（本社：東京都小平市、代表取締役社長：奥山幸祐）に対し、今後の事業推進に必要な資金として6億円を上限とする出資を行うことを決定し、その一部の出資を実行しました。

またフローディアに対しては、三菱UFJキャピタル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：安藤啓）、大和企業投資株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川崎憲一）も出資を実行しました。

\*不揮発性メモリー：半導体メモリーの中でも、電源供給を行わない状態でも書き込まれたデータが消えない半導体メモリーの総称。フローディアでは不揮発性メモリーをIP（回路ブロック）としてライセンス提供している

フローディアは、ルネサス エレクトロニクス株式会社でフラッシュメモリーを開発していたエンジニアが2011年に設立したベンチャー企業です。メモリー製造に必要な工程・回路設計を、IP（回路ブロック）としてライセンス提供するビジネスモデルを展開しています。フローディアの開発チームは、回路設計だけでなく製造プロセスの細部にまで精通しているエンジニアで構成されており、顧客の要求スペックに応じた最適メモリーの開発を実現できることが強みとなっています。

スマートフォン、タブレットなどのバッテリー駆動の端末が日進月歩で高機能化している中、基幹部品の一つであるメモリーも、更なる省電力・省スペース・低コスト化が求められています。その中で組込み型不揮発性メモリーは、プログラム格納、データ保存、性能調整（トリミング）、暗号キーの保存など幅広い用途があり、需要が拡大しています。フローディアは、追加コストを極力抑えながら、不揮発性メモリーを他の演算用半導体と同じチップに埋め込む技術を開発し、低コスト化、省スペースを実現しました。さらにフローディアの組込み型不揮発性メモリーは、電子書込みに際しFNトンネル方式\*を使うことで、メモリーセル1個当たりの消費電力を従来の10万～100万分の1程度に抑えることを可能にしました。

\*FNトンネル方式：ゲートと基板間に高電圧をかけ、電子が電荷蓄積層に移動する（トンネル効果）ことで、不揮発メモリー化させる

今後普及が見込まれるIoT（Internet of Things）製品の構成部品としてもメモリーは不可欠です。フローディアの低コスト、低消費電力のメモリーは、ビーコンや各種センサーなどのIoT端末の大量普及を可能にし、IoTビジネスの収益性を高めること

で、今後のIoT市場の拡大に貢献することが期待されます。

また、半導体の集積度が進むにつれ、製造コストがさらに高騰する半導体製造メーカーやファブレス企業にとっても、フローディアの汎用性・利便性の高いメモリーを導入することで、製造コストと量産立ち上げ期間を削減することができます。

INCJはフローディアに対して、今後の事業推進に必要な資金を供給するとともに、社外取締役の派遣、事業開発体制の強化、戦略パートナーとの提携支援などの経営サポートを行います。INCJは上記の取り組みを通じ、組込み型不揮発性メモリーの広がりをも促進し、半導体市場やスマートフォン・IoT市場の発展に寄与できるよう支援してまいります。

### 株式会社フローディアについて

設立	2011年4月
事業内容	組込み型不揮発性メモリーの設計開発
本社所在地	東京都小平市小川東町1丁目30番9号
代表取締役社長	奥山 幸祐（おくやま こうすけ）

### 株式会社産業革新機構（INCJ）について

INCJは、2009年7月にオープンイノベーションの推進を通じた次世代産業の育成を目指して、法律に基づき設立された会社です。総額約2兆円の投資能力を有しており、革新性を有する事業に対し出資等を行うことで産業革新を支援することをミッションとしています。

INCJは、投資・技術・経営等で多様な経験をもつ民間人材によって運営されており、法令に基づき、当社内に設置している産業革新委員会にて、政府の定める支援基準に従って投資の可否の判断を行い、日本の産業革新に資する投資を実施いたします。

（本発表資料のお問い合わせ先）

（株）産業革新機構（INCJ） 企画調整室 畑、市原、大森  
東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング21階  
電話：03-5218-7200（大代表）